# 高 T。氧化物晶界结\*

## 戴远东 马平 杨涛

(北京大学人工微结构和介观物理国家重点实验室 北京大学物理系 北京 100871)

摘 要 高温超导氧化物的晶界形成超导 Josephson 弱连接,人工制作的晶界(例如双晶衬底上外延生长高 T<sub>e</sub> 超导薄膜形成的晶界)是弯曲的小折线,即晶界小面化了.超导序参数 d 波对称性和晶界小面化对晶界结的性质有重要影响.文章综述了近几年来国际上在有关方面的研究动态.

关键词 高温超导电性 ,晶界结 ,序参数 ,d 波对称性

#### GRAIN-BOUNDARY JUNCTIONS IN HIGH T<sub>c</sub> SUPERCONDUCTING OXIDES

DAI Yuan-Dong MA Ping YANG Tao

( The Mesoscopic Physics State Key Laboratory and Department of Physics , Peking University , Beijing 100871 , China )

Abstract Superconducting Josephson weak links can be produced at the grain-boundary in high transition temperature  $T_c$  ) superconducting oxides. Artificial grain-boundaries , such as the bicrystal grain-boundary formed by the epitaxial growth of a high  $T_c$  thin film on a bicrystal substrate , is a wavy line and faceted. The *d*-wave pairing symmetry of the superconducting order parameter and the faceting of the grain-boundary have important effects on the characteristics of the grain-boundary. We review the relevant research of recent years in this field.

**Key words** high transition temperature superconductivity, grain-boundary junction, superconducting order parameter, *d*-wave pairing symmetry

### 1 引言

高温超导体发现不久,人们就观察到取向不同 的晶粒之间所形成的晶界具有超导 Josephson 弱连 接的特性,形成了所谓的晶界结.目前,晶界结不仅 成为研究高温超导弱连接及高温超导机理的重要工 具之一,而且它也是制作高温超导弱连接器件的主 要方法;另一方面,晶界的临界电流密度 J。非常低, 比体内的 J。要低 2—4 个数量级,这大大限制了高 温超导体的通电能力,在针对高温超导体强电应用 的材料研究中,如何克服颗粒晶界弱连接便成为十 分重要的课题.因而,晶界一直是高温超导研究中的 一个热点.为了进行深入研究,人们设计和制作了不 同晶界夹角的人工晶界结.其方法是在不同夹角的 双晶衬底上外延生长高 T。超导氧化物薄膜,其晶界 夹角就是预先设计的双晶衬底的晶界角.外延生长 形成晶界结,晶界的法线总在 ab 平面内.对双晶界 结的研究有几个重要发现.晶界的微观结构观察表 明,虽然双晶衬底的晶界十分平直,但在外延生长的 薄膜上,晶界不是直线,而是围绕衬底晶界直线曲折 地变化(小面化)<sup>11</sup>,这从薄膜制备过程中晶粒生长 速度的各向异性特征是容易解释的.晶界结的临界 电流的研究表明,当晶界夹角( $\theta$ )只有几度时,对临 界电流密度影响不大;当 $\theta$ 大于10°时,临界电流密 度  $J_e$ 迅速降低;当 $\theta$ 为45°时, $J_e$ 趋于零,而且不同 的实验结果较为分散.平均地讲, $J_e$ 随 $\theta$ 呈指数减 小<sup>[2]</sup> 晶界的特征电压  $V_e = J_e R_n$  也随晶界角 $\theta$ 的 增加而迅速下降.

在高温超导电性的机理研究方面,人们发现了 高温超导铜氧化物的超导序参数具有 d 波对称性.

<sup>\*</sup> 国家重点基础研究专项经费资助(编号 G1999064607, G1999064609)、国家八六三计划资助(编号 863-CD050101) 2001 – 04 – 04 收到

在实验的精度范围内,目前认为它属  $d_{x^2-y^2}$  对称 性<sup>[3]</sup>.这种对称性对晶界结的性质有重要影响,它不 仅使晶界的临界电流减小,在某些情况下,它使晶界 结成为  $\pi$ 结,即结中电流  $I = I_e \sin \varphi$ ,但  $I_e < 0$ .在 d波配对和晶界小面化的框架下,研究晶界结的性质 自然成为研究热点.

本文将对近几年来国际上在这方面研究的主要 结果作一简单介绍.

2 d 波对称性和  $\pi$  结

现在已经清楚,高温超导氧化物的超导序参数 具有  $d_{x^2-y^2}$ 对称<sup>[3]</sup>,能隙函数  $\Delta(\mathbf{k}) = \Delta_0 \cos 2\theta$ ,其中  $\mathbf{k}$  是波矢在 xy 平面内的投影, $\theta$  为 $\mathbf{k}$  与 $\mathbf{k}_x$  轴的夹角 (高温超导体的费米面近似柱状,与  $\mathbf{k}_z$  关系不大). 在 CuO<sub>2</sub> 平面内, $a_x b$  轴相互垂直,因而倒格矢  $\mathbf{k}_x$  的 方向即与晶轴  $a(\mathbf{g} b)$ 一致.这种能隙函数的特点 是,在[110]方向( $\theta = \frac{\pi}{4}$ )有节点( $\Delta = 0$ ),而且旋转 90°以后能隙函数变号(或增加了一个位相  $\pi$ ), $\Delta(\theta$  $+\frac{\pi}{2}) = -\Delta(\theta) = \Delta(\theta)e^{i\pi}$ .

对于在双晶衬底上外延生长的 *c* 轴取向薄膜, 其晶界如图 1 所示,按照 *d* 波对称性的观点,通过 这种晶界的临界电流密度<sup>41</sup>:

 $J_{\rm c} = J_{\rm c0} \cos 2\theta_1 \cos 2\theta_2$  , (1)其中  $J_{e0}$ 为体内的临界电流密度  $\partial_1$  和  $\partial_2$  分别是晶 界两侧晶体 a 轴与晶界之间的夹角 , $\theta = \theta_1 + \theta_2$  为 两侧晶体的失配角.(1) 式表明如果两侧晶体的晶轴 与晶界的夹角  $\theta_1$  和  $\theta_2$  中有一个小于  $\frac{\pi}{4}$  ,另一个大 于 $\frac{\pi}{4}$ (这是很容易实现的),则 $J_c < 0$ ,此时结中电流 与结两侧量子相位差的关系仍为  $I = I_{e} \sin \varphi$  ,但  $I_{e}$ 为负,  $I = - |I_c| \sin \varphi = |I_c| \sin(\varphi - \pi)$ , 如果仍认为 临界电流为正 则相当于结上的量子相位差附加了  $\pi$  因而称为  $\pi$  结.相对而言,通常  $I_{\mu}$  为正的结常称 做'0'结. Tsuei 的三晶实验<sup>[3]</sup>中直接证实了  $\pi$  结的 观点.像 Tsuei 在论文中所显示的那样,在一个包含 几个 Josephson 结的超导环中,如果有奇数个 $\pi$ 结, 且环的电感参数  $\beta = \frac{2\pi LI_e}{\phi_o} >> 1( 其中 L 为环电感 ,$ I。是各结临界电流的最小值),为保持超导波函数 的单值性和使自由能极小 在外磁场为零时 环中会

自发形成一个环流,产生自发磁化,并在环中形成半 个磁通量子  $\phi_0/2$ ,  $\phi_2 = \frac{\eta}{2e} = 2.07 \times 10^{-11} \text{ T} \cdot \text{cm}^2$ .



# 3 高温超导氧化物晶界结的小面化及其对 J。的影响

I.W.Seo 等<sup>[1]</sup>用高分辨电镜较系统地研究了在 双晶衬底上沿 c 轴方向外延生长的 YBCO 薄膜的晶 界 发现晶界的"小面化"(即实际晶界为围绕衬底晶 界附近来回摆动的曲折线 )是一个普遍现象,这样, 实际的晶界由许多小段晶界结组成.晶界与两侧晶 体的晶轴夹角  $\theta_1$  和  $\theta_2$  满足  $\theta = \theta_1 + \theta_2$  ,但对于各个 小段  $\theta_1$ 、 $\theta_2$  不相同  $\theta_1$  和  $\theta_2$  一般对应于晶体的一些 低指数面,如果每一个小段的临界电流密度都按 d,2\_,2 配对的公式(1)来表明,则各小段晶界结临界 电流密度是不相同的,总的临界电流等于各小段晶 界结临界电流之和.在(1)式中,当 $\theta_1 = \theta_2 = \frac{\theta}{2}$ 时取 极大值 ,当  $\theta_1 \neq \theta_2$  时 ,其值有所下降.特别是当  $\theta$  较 大时 实际晶界的剧烈摆动常使某些小段会出现  $\theta_1$ 和  $\theta_2$  中有一个大于  $\frac{\pi}{4}$  的情形 ,此时按公式(1) 临界 电流变成负值,即变成了上节所说的 $\pi$ 结, $\theta$ 角越 大 π 结出现得越多 ,因而总的临界电流下降得越 多[5].图2给出了一个例子,其中横轴是沿着晶界走 向的坐标.该图是按透射电镜所观察到的各段晶界 的实际夹角  $\theta_1$  和  $\theta_2$  按公式(1)计算得到的临界电 流密度分布.  $J_{e} = 0$  的小段表示  $\theta_{1}$  和  $\theta_{2}$  中有一个取  $\frac{\pi}{4}$ 值.

H. Hilgenkamp 等<sup>[5]</sup>针对上述图像进行了定量的 研究. 按照(1)式,在  $d_{x^2-y^2}$ 图像下,对于平直的对称 晶界( $\theta_1 = \theta_2 = \frac{\theta}{2}$ )和非对称晶界( $\theta_1 = \theta, \theta_2 = 0$ )的 临界电流密度很不相同. 不对称平直晶界的临界电



流密度较低;对于  $\theta = 45^{\circ}$ 的平直非对称晶界( $\theta_1 = 45^{\circ}, \theta_2 = 0$ ),  $J_e = 0$ . 该文献进一步计算了小面化对临界电流的影响,结果表明,在 d 波配对情况下,小面化使晶界的临界电流密度进一步降低,但计算结果仍比实验测量到的实际临界电流密度要高得多,见图 3.



由上面的分析可以看到,高温超导体序参数的 *d* 波对称性和实际晶界的小面化,对高温超导体临 界电流的降低起了主要作用,但 *J*。随失配角 θ 的增 加所表现出的强烈减少还有其他更重要的原因.最 新的研究证明它主要来自于晶界处的大量结构缺陷 所造成的载流子浓度的明显减少<sup>61</sup>.

### 4 45°非对称晶界的特殊性

对于一个平直的非对称  $45^{\circ}$  晶界 , $\theta_1 = \theta = 45^{\circ}$  ,  $\theta_2 = 0$  按照  $d_{z^2 - z^2}$  配对的公式(1),其临界电流密度 应当为零.实际的晶界弯弯曲曲 , $\theta_1 < 45^{\circ}$ 和  $\theta_1 > 45^{\circ}$ 交替出现 因而在这种晶界上必然出现大量临界电 流为负的  $\pi$  结, 虽然' 0'结和  $\pi$  结在晶界总长度中所 占份额不会完全相等,但平均地说这种晶界的临界 电流密度仍然很小,同时还使这种晶界具有一些特 别的性质,当我们跨越晶界做一个闭合回路时,此回 路两次跨越晶界,这个回路可能是一个"0"环(要通 过两个"0"结或两个 $\pi$ 结),但也非常有可能是一个 π环(通过一个"0"结和一个 π结),这样类似 Tsuei 的三晶  $\pi$  环实验.在我们所划的  $\pi$  环中 即使处在零 外磁场中也会自发磁化产生一定的磁通.由于晶界 的弯曲很不规则 沿晶界走向中 0 "结和 π 结的分布 是不规则的 因而沿着这样的晶界 在零外磁场中也 应当有不规则的磁通分布,人们用扫描 SOUID 显微 镜对在零外磁场中的 45°非对称晶界做了仔细的测 量<sup>5]</sup>确实观测到沿这种晶界的不规则磁通分布,见 图 4.



这种晶界的另一个特殊性质是临界电流对垂直 于膜面磁场的依赖 ,图 5 给出了 16 $\mu$ m 宽的非对称 45°晶界结临界电流  $I_c$  对外加磁场的依赖<sup>[5]</sup>,这一现 象容易从  $d_{x^2-y^2}$ 配对和晶界小面化来解释.这种晶 界是由部分" 0 "结和部分  $\pi$  结组成的.与这类结类似 的特殊例子是单晶上的角结<sup>[7]</sup>,其中一个" 0 "结和一 个  $\pi$  结长度相等 ,且其临界电流密度相等 ,只是前者 为正 ,后者为负.按照  $d_{x^2-y^2}$ 配对的观点 ,在零外磁 场中此结的临界电流为零 :

$$\begin{aligned} U_{\rm c} &= \frac{l}{2} J_{\rm c} \sin \varphi + \frac{l}{2} J_{\rm c} \sin (\varphi - \pi) \\ &= \frac{l}{2} J_{\rm c} (\sin \varphi - \sin \varphi) \equiv 0 , \end{aligned}$$

其中 l 为结的长度.当加一个外磁场后 ,超导序参数 位相差的空间调制变化将使  $I_e \neq 0$ ,对应于某个特 定磁场 , $I_e$  将出现极大.非对称 45°晶界是多个"0" 结和  $\pi$  结交替出现 ,在晶界总长的范围内 ,两种结所 占百分数近似相等.定性地说 ,其临界电流对外磁场 的依赖与单晶上的角结类似 ,只是更为复杂.

非对称晶界结的另一特征是超流与量子相位差  $\varphi$ 间的非正弦依赖关系.在一个超导弱连接中,超流  $I_s$ 与弱连接两侧超导序参数量子相位差  $\varphi$ 之间的 正弦关系只对 SIS Josephson 隧道结而言才是严格正 确的.一般而言, $I_s$ 是  $\varphi$  的周期函数,周期为  $2\pi$ .在 有些弱连接中(例如长度  $l > \xi$  的超导微桥)对正弦 关系 sin $\varphi$  的偏离是明显的,这在低温超导体微桥中 已表现得很明显.对于 d 波配对的高温超导氧化 物,这种情形完全可能发生,这样,虽然晶界结上的 超流  $I_s$  仍为结两侧超导波函数量子相位差  $\varphi$  的周 期函数,但也不完全是正弦关系.忽略高次项,超流 可表示为

$$I_{\rm s} = I_1 \sin\varphi + I_2 \sin^2\varphi , \qquad (2)$$

其中可以认为  $I_1$  由(1)式表示.对于 45°非对称晶 界  $\theta_1 = \theta = 45^\circ$   $\theta_2 = 0$  因而  $I_1$  会非常小.若  $I_1 \ll I_2$ , 则  $I_s = I_2 \sin 2\varphi$ .按照超导量子干涉器件的原理,对 于包含有一个这种结的超导环,在这个结上的超流 受到外加磁通调制的周期应为通常的 Josephson 结 的一半,即为  $\phi_0/2$ , $\phi_0$  为磁通量子.E.II'iche<sup>[8]</sup>等设 计了相应的实验,他们在 45°非对称双晶衬底上制备 了一个 rf SQUID,测量了它对外磁场的响应,并与 36°对称双晶晶界结的 rf SQUID 作了对比,发现在低 温下,前者对外磁通响应的周期确是  $\phi_0/2$ ,但当温度 升到 30—40K 以上时,响应又逐渐过渡到  $\phi_0$ ,表现 为在低温下  $I_1 \ll I_2$ ,随温度上升,逐渐又过渡到  $I_1 \gg$  $I_2$ .E.II'iche<sup>[9]</sup>等还从一个非回滞模式 rf SQUID 的  $V_r$ 和  $I_r$ 之间的振幅、相位关系的变化,反推出超流  $I_s$ 与  $\varphi$  之间的关系,结果也表明,在低温下, $I_s$ 与  $\varphi$ 之间的关系严重地偏离正弦行为.

### 5 结束语

高温超导体的  $d_{x^2-y^2}$  配对加上晶界的小面化行 为可以部分地说明高温超导体临界电流及对磁场依 赖的特点,但还余留下一些重要问题尚未解决.例 如, $J_{e}(\theta)$ 的指数关系和  $J_{e}(\varphi)$ 的非正弦行为及其随 温度的变化.

#### 参考文献

- [1] Seo J W ,Kabius B ,Dähne U et al . Physica C ,1995 245 25
- [2] Dimos D , Chaudhari P , Mannhart J. Phys. Rev. , 1990 , B41 4038
- [ 3 ] Tsuei C C et al. Phys. Rev. Lett. ,1994 ,73 593
- [ 4 ] Sigrist M ,Rice T M. J. Phys. Soc. Jpn. ,1992 61 4283
- [5] Hilgenkamp H, Mannhart J, Mayer B. Phys. Rev., 1996, B53: 14586
- [ 6 ] Hammerl G et al. Nature 2001 A081 :162
- [7] Wollman D A et al. Phys. Rev. Lett. ,1995,74,797
- $\left[ \begin{array}{c} 8 \end{array} \right]~$  Il'ichev E Jakosareuko V J<br/>jsselsteijn R Jet~al . Preprinted paper .
- [ 9 ] Il'ichev E et al. Phys. Rev. Lett. ,1998 &1 894

# 公 告

为庆祝 2002 年《物理》创刊 30 周年,本刊拟在 2002 年 1 月制作"《物理》创刊 30 周年纪 念光盘",光盘将全文收录《物理》自 1972 年创刊到 2001 年 12 月出版的所有内容.若作者不 同意将自己的文章收录入光盘,请在 2002 年 1 月 15 日之前函告编辑部,如无来函,本刊将视 为同意.光盘不另付作者稿酬.特此声明并公告所有作者.

《物理》编辑部